

РЕЗОНАНСНАЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХМЕРНОГО ТУННЕЛЬНОГО ПЕРЕХОДА СО СЛАБЫМ СТРУКТУРНЫМ БЕСПОРЯДКОМ

В. Я. Кирпиченков*

Новочеркасский государственный технический университет
346400, Новочеркасск, Россия

Поступила в редакцию 12 февраля 1999 г.

При температуре $T = 0$ в одноэлектронном приближении получены нелинейная резонансная вольт-амперная характеристика (ВАХ) трехмерного туннельного перехода со слабым (малые концентрации примеси) структурным беспорядком и формула для величины мезоскопических флуктуаций его резонансного статического туннельного контактанса.

PACS: 71.55.Iv

1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе результаты, полученные в [1] для квазиодномерного туннельного перехода со слабым структурным беспорядком, обобщаются на случай трехмерного перехода в наиболее интересной — резонансной — ситуации, когда резонансное подбарьерное примесное рассеяние туннелирующих электронов приводит к радикальному отличию ВАХ туннельного перехода с примесями от ВАХ «пустого» (без примесей) туннельного перехода. При этом используются представления о квантовых резонансно-перколяционных траекториях в туннельных переходах со слабым структурным беспорядком, развитые в [2].

В одноэлектронном приближении при $T = 0$ с помощью разложения по степеням концентрации примеси получены вид нелинейной резонансной ВАХ туннельного перехода с примесями, формула, определяющая величину мезоскопических флуктуаций его резонансного статического туннельного контактанса, а также ограничения снизу на поперечные размеры барьерного слоя, вытекающие из условия малости этих флуктуаций.

2. МОДЕЛЬ. ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Как и в [1], будем рассматривать модель туннельного перехода в виде сэндвича $N-I-N$, представляющего собой два одинаковых нормальных металла N , разделенных плоским слоем изолятора I , толщиной L и площадью S с вкрапленными в него примесями.

*E-mail: p0ncls@novoch.ru

Для электронов проводимости N -металлов будем предполагать трехмерный изотропный квадратичный закон дисперсии $\varepsilon = k^2 (\hbar^2/2m = 1, \hbar = 1, m = 1/2)$ с фермиевской энергией ε_F .

Электроны в барьере предполагаются невзаимодействующими между собой (одно-электронное приближение), а для барьерного потенциала $U(\mathbf{r})$ (заряд электрона $e = 1$) в области $0 \leq x \leq L$, занятой изолятором, в отсутствие электрического напряжения ($v = 0$) на барьере примем модель структурного беспорядка

$$U(\mathbf{r}) = U_0 + U_{imp}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{r} = (x, \rho), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (1)$$

где $U_0 = \text{const} > \varepsilon_F$ — регулярный потенциал однородного барьера без примесей, $U_{imp}(\mathbf{r})$ — случайный потенциал, порожденный системой N одинаковых хаотически распределенных по слою изолятора примесей:

$$U_{imp}(\mathbf{r}) = \sum_{0 \leq x_j \leq L} \hat{u}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_j), \quad (2)$$

где точки \mathbf{r}_j макроскопически равномерно распределены по объему $V = SL$ слоя с плотностью $n = N/V$, а $\hat{u}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_j) < 0$ — локальный потенциал притяжения электронов к примеси в точке \mathbf{r}_j с радиусом действия r_0 .

В рассматриваемом здесь случае малых концентраций примесей предполагаются выполненными следующие соотношения для характерных параметров размерности длины, позволяющие выполнить процедуру разложения туннельного тока по степеням концентрации примесей [2, 3]:

$$r_0 \ll \alpha_F^{-1} \ll n^{-1/3} < L, \quad (3)$$

где $\alpha = \alpha(\varepsilon) = (U_0 - \varepsilon)^{1/2}$, $\alpha_F^{-1} = \alpha^{-1}(\varepsilon_F)$ — характерная длина затухания электронного состояния с энергией ε_F в однородном барьере.

При напряжениях $v \ll \varepsilon_F$, $U_0 - \varepsilon_F$ и $T = 0$ формулы для туннельного тока $\langle i(v) \rangle$, туннельного кондактанса $\langle G(v) \rangle$ и их относительных среднеквадратичных флуктуаций $\langle \delta^2(v) \rangle^{1/2}$ представим в виде

$$\langle i(v) \rangle = \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F+v} \langle g(\varepsilon) \rangle d\varepsilon, \quad \langle G(v) \rangle = v^{-1} \langle i(v) \rangle, \quad (4)$$

$$\langle \delta^2(v) \rangle^{1/2} = \left[\frac{\langle i^2(v) \rangle - \langle i(v) \rangle^2}{\langle i(v) \rangle^2} \right]^{1/2}, \quad (5)$$

где

$$\langle i^2(v) \rangle = \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F+v} \langle g(\varepsilon)g(\varepsilon') \rangle d\varepsilon d\varepsilon', \quad (6)$$

$$g(\varepsilon) \equiv g(\varepsilon, \Gamma_N) = \iint D(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, \Gamma_N) \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} d^2 \rho, \quad (7)$$

$D(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, \Gamma_N)$ — туннельная прозрачность барьера со случайной примесной конфигурацией $\Gamma_N = \{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N\}$ для электронов с энергией ε , имеющих на «входе» в барьер

фиксированную поперечную компоненту импульса q , а на «выходе» — фиксированную поперечную координату ρ , интегрирование по q осуществляется по всем $0 \leq q^2 \leq \epsilon$, по ρ — в пределах площади барьера S . Усреднение в (4), (6) осуществляется по множеству примесных конфигураций $\{\Gamma_N\}$:

$$\langle g(\epsilon) \rangle = \frac{1}{\Delta\Gamma_N} \int_{\{\Gamma_N\}} g(\epsilon, \Gamma_N) d\Gamma_N, \quad (8)$$

$$\langle g(\epsilon)g(\epsilon') \rangle = \frac{1}{\Delta\Gamma_N} \int_{\{\Gamma_N\}} g(\epsilon, \Gamma_N)g(\epsilon', \Gamma_N) d\Gamma_N, \quad (9)$$

где $d\Gamma_N = dr_1 dr_2 \dots dr_N$, $\Delta\Gamma_N = V^N = (LS)^N$, $N = nV$.

3. РЕЗОНАНСНЫЙ ТУННЕЛЬНЫЙ ТОК КАК СУММА ПО КВАНТОВЫМ РЕЗОНАНСНО-ПЕРКОЛЯЦИОННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ

Как показал анализ квазиодномерного случая [1], наиболее радикальное отличие ВАХ барьера с примесями от ВАХ «пустого» барьера проявляется в условиях резонансного туннелирования, когда энергии ϵ туннелирующих частиц близки к энергии ϵ_0 локального однопримесного уровня. Поэтому ниже рассматривается ситуация, когда $\epsilon_F = \epsilon_0$ при $v = 0$. В этом случае при каждой энергии ϵ , близкой к ϵ_F , фазовое пространство $\{\Gamma_N\}$ факторизуется в виде совокупности резонансных и нерезонансных областей и главный вклад в средние (8), (9) при рассматриваемых здесь малых концентрациях примесей дают резонансные области, соответствующие уединенным слабоизвилистым квантовым резонансно-перколяционным траекториям [2].

Вычисления средних (8), (9) существенно опираются на следующие представления о пространственной структуре квантовых резонансно-перколяционных траекторий при ϵ близких к ϵ_0 . Идеальная уединенная кратчайшая m -центровая ($m = 1, 2, \dots$) траектория представляет собой строго периодическую цепочку m примесей, расположенных на расстоянии $2y = L/m$ друг от друга, причем первая и последняя примеси в цепочке находятся на расстоянии y от соответствующих границ барьерного слоя. При этом в трубке радиусом $\sim 2y$ вокруг цепочки не должно быть других примесей, кроме принадлежащих данной траектории (условие уединенности, обеспечивающее совместно с условиями периодичности цепочки и близости ϵ к ϵ_0 резонансное туннелирование электронов вдоль квантовых резонансно-перколяционных траекторий с коэффициентом прозрачности $D_m^{res} \sim 1$). Однако фазовый объем в пространстве $\{\Gamma_N\}$, занимаемый такой идеальной строго периодической квантовой резонансно-перколяционной траекторией, а следовательно, и вероятность ее образования равны нулю. Поэтому при вычислении (8), (9) нужно учесть, что коэффициенты прохождения вдоль этой траектории D_m^{res} существенно не меняются, оставаясь порядка единицы, если координаты примесей отличаются от своих значений в идеальной квантовой резонансно-перколяционной траектории вдоль оси x на величину $\delta x \lesssim \alpha^{-1}$ и на величину $\delta \rho \lesssim y\theta$ в поперечном направлении (где $\theta \ll 1$ — угол, характеризующий извилистость траектории). При этом параметры m, y, θ для слабоизвилистых траекторий не являются независимыми и свя-

заны соотношением [2]

$$m = \frac{\mathcal{L}}{u} \left(1 + \frac{\theta^2}{2} \right), \quad (10)$$

где $\mathcal{L} = \alpha L$, $u = 2\alpha y$ — соответственно безразмерные толщина барьерного слоя и шаг квантовой резонансно-перколяционной траектории. Поэтому при вычислениях (8), (9) в качестве независимых можно выбрать любые два из трех параметров, входящих в (10). Ниже ими являются m, u .

Таким образом, при $N \gg 1$, $\alpha_F^3 V \gg 1$ и учете лишь главного вклада, даваемого траекториями, среднее (8) приводится к виду

$$\langle g(\varepsilon) \rangle = S \sum_{m=1}^{\infty} \int p_m(\varepsilon, u) g_m^{res}(\varepsilon, u) du, \quad (11)$$

где

$$p_m(\varepsilon, u) = \alpha^2(\varepsilon) c^m e^{-cm\pi u^3} (u^2 \theta^2(m, u))^{m-1} \quad (12)$$

— вероятность образования на единицу площади барьерного слоя уединенной m -центрковой квантовой резонансно-перколяционной траектории с шагом u , $c = n\alpha^{-3}$ — безразмерная концентрация примесей, $\theta^2(m, u)$ выражается из (10):

$$g_m^{res}(\varepsilon, u) = \iint D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u) \frac{d^2 q}{(2\pi)^2} d^2 \rho, \quad (13)$$

где $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u)$ — коэффициент прозрачности барьера с одной m -центрковой траекторией, имеющей шаг u .

Отметим, что зависимость $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u)$ от напряжения v при $v \ll U_0 - \varepsilon_F$, ε_F можно пренебречь, поскольку ее учет дает относительную поправку порядка $v/(U_0 - \varepsilon_F) \ll 1$ к величине $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u) \sim 1$, вычисленной при $v = 0$ в трубке резонансной прозрачности вдоль квантовой резонансно-перколяционной траектории.

Подставляя теперь (11) в (4), учтем, что $p_m(\varepsilon, u)$ — плавная функция ε в окрестности ε_F , а $g_m^{res}(\varepsilon, u)$ — резко изменяющаяся функция ε , «сосредоточенная» в ближайшей окрестности ε_F , и поэтому при интегрировании по ε можно вынести за интеграл $p_m(\varepsilon, u)$ в точке $\varepsilon = \varepsilon_F$. В результате представим туннельный ток (4) в виде

$$\langle i(v) \rangle = S \sum_{m=1}^{\infty} \int p_m(\varepsilon_F, u) i_m(v, u) du, \quad (14)$$

где

$$i_m(v, u) = \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F + v} g_m^{res}(\varepsilon, u) d\varepsilon \quad (15)$$

— туннельный ток, проходящий вдоль одной m -центрковой траектории, имеющей шаг u .

Таким образом, (14) (при учете (12)) представляет резонансный туннельный ток $\langle i(v) \rangle$ в виде суммы ряда по степеням концентрации, m -й член которого дает вклад m -центрковых траекторий в $\langle i(v) \rangle$.

Аналогично и (6) приводится к виду

$$\langle i^2(v) \rangle = S^2 \sum_{m,m'=1}^{\infty} \int \left[1 + \frac{1}{S} \omega_{m,m'}(\varepsilon_F; u, u') \right] p_m(\varepsilon_F, u) p_{m'}(\varepsilon_F, u') \times \\ \times i_m(v, u) i_{m'}(v, u') du du', \quad (16)$$

где

$$\omega_{m,m'}(\varepsilon_F; u, u') = \pi \alpha_F^{-2} u^2 \left[\frac{\alpha_F^2}{\pi u^2 p_m(\varepsilon_F, u)} \delta_{m,m'} \delta(u - u') - 1 \right], \quad (17)$$

$\delta_{m,m'}$ — символ Кронекера, $\delta(u - u')$ — дельта-функция.

Слагаемое $S^{-1} \omega_{m,m'}(\varepsilon_F; u, u')$ в (16) учитывает парные статистические пространственные корреляции между траекториями, обусловленные требованием их уединенности.

Подставляя (14) и (16) в (5), получим

$$\langle \delta^2(v) \rangle^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{S}} \times \\ \times \left[\frac{\sum_{m,m'} \int \omega_{m,m'}(\varepsilon_F; u, u') p_m(\varepsilon_F, u) p_{m'}(\varepsilon_F, u') i_m(v, u) i_{m'}(v, u') du du'}{\left(\sum_m \int p_m(\varepsilon_F, u) i_m(v, u) du \right)^2} \right]^{1/2}. \quad (18)$$

Для дальнейших вычислений по формулам (14), (18) необходимо найти входящий в (13) коэффициент туннельной прозрачности $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u)$.

4. ВЫЧИСЛЕНИЕ $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u)$

В [2] найдена локальная прозрачность барьера, содержащего m -центровую траекторию с шагом u для частного случая нормально ($\mathbf{q} = 0$) падающих на барьер частиц с энергией ε . Здесь в рамках той же методики обобщена на случай произвольного \mathbf{q} задача вычисления коэффициента прозрачности $D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u)$ и найдена (более детально) его зависимость от ε .

Уравнение Шредингера в области барьера (с одной m -центральной квантовой резонансно-перколяционной траекторией) имеет вид ($v = 0$)

$$\Delta \psi - \alpha^2 \psi = \sum_{j=1}^m \hat{u}_j \psi, \quad 0 \leq x, x_j \leq L, \quad \alpha^2 = U_0 - \varepsilon, \quad \hat{u}_j = \hat{u}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_j). \quad (19)$$

На границах барьера $x = 0$ и $x = L$ при всех ρ выполнены условия непрерывности для ψ и ее нормальных производных $\partial \psi / \partial x$.

Слева от барьера ($x < 0$) функция $\psi(x, \rho)$ представляет собой суперпозицию падающей на барьер с поперечным импульсом \mathbf{q} и отраженной волн:

$$\psi(x, \rho) = a_q \exp(ik_q x + iq\rho) + \int b_s \exp(-ik_s x + is\rho) \frac{d^2 s}{(2\pi)^2}, \quad k_s = \sqrt{\varepsilon - s^2}. \quad (20)$$

Справа от барьера ($x > L$) функция $\psi(x, \rho)$ — проходящая волна:

$$\psi(x, \rho) = \int c_s \exp(ik_s(x - L) + is\rho) \frac{d^2 s}{(2\pi)^2}. \quad (21)$$

Интегрирование по s в (20), (21) осуществляется по всем $0 \leq s^2 \leq \varepsilon$, спектральные амплитуды c_s, b_s зависят среди прочего и от параметров траектории m, u .

Предметом вычисления является коэффициент прохождения

$$D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u) = \frac{j_x^{out}(\varepsilon, \rho, u)|_{x=L}}{j_x^{in}(\varepsilon, \mathbf{q})|_{x=0}}, \quad (22)$$

где

$$j_x^{out}(\varepsilon, \rho, u)|_{x=L} = 2 \operatorname{Re} \int k_s c_s c_{s'}^* \exp\{i(s - s')\rho\} \frac{d^2 s}{(2\pi)^2} \frac{d^2 s'}{(2\pi)^2} \quad (23)$$

— x -компонента вектора плотности проходящего потока в точке (L, ρ) ,

$$j_x^{in}(\varepsilon, \mathbf{q})|_{x=0} = 2k_q |a_q|^2 \quad (24)$$

— x -компонента вектора плотности падающего потока на плоскости $x = 0$.

Таким образом, подставляя (23), (24) в (22), получаем

$$D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u) = \operatorname{Re} \int \frac{k_s c_s c_{s'}^*}{k_q |a_q|^2} \exp\{i(s - s')\rho\} \frac{d^2 s}{(2\pi)^2} \frac{d^2 s'}{(2\pi)^2}. \quad (25)$$

Дальнейшая задача состоит в нахождении связи между c_s и a_q путем решения уравнения (19) с упомянутыми выше граничными условиями на плоскостях $x = 0, x = L$.

Аналогично [2] эта задача сводится к решению замкнутой системы m алгебраических уравнений:

$$\varphi_{j+1} - \frac{1}{\mu h} \varphi_j + \varphi_{j-1} = 0, \quad 2 \leq j \leq m - 1, \quad (26)$$

$$\left(\frac{1}{\mu h} + \frac{\alpha + ik}{\alpha - ik} \right) \varphi_1 + \varphi_2 = f_q a_q, \quad (27)$$

$$\left(\frac{1}{\mu h} + \frac{\alpha + ik}{\alpha - ik} \right) \varphi_m + \varphi_{m-1} = 0, \quad (28)$$

для величин

$$\varphi_k = \int \hat{u}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_k) \psi(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad k = 1, 2, \dots, m, \quad (29)$$

где

$$f_q = -\frac{2ik_q}{\alpha_q - ik_q} \frac{e^{-\alpha_q y}}{4\pi^2 h}, \quad y = \frac{u}{2\alpha}, \quad h = \frac{\alpha e^{-u}}{4\pi u}, \quad \alpha_q = \sqrt{U_0 - \varepsilon - q^2}, \quad (30)$$

$\mu = \mu(\varepsilon)$ — введенная в [2] амплитуда подбарьерного рассеяния на примеси.

Из условий непрерывности на плоскости $x = L$ искомая амплитуда c_s выражается через величину φ_m [2]:

$$c_s = -\frac{\exp(-\alpha_s y - i s \rho_m)}{\alpha_s - i k_s} \varphi_m, \quad (31)$$

где ρ_m — поперечная координата m -й примеси (ближайшей к плоскости $x = L$) в цепочке.

Решение (26) может быть представлено в виде

$$\varphi_j = C_1 \lambda_1^j + C_2 \lambda_2^j, \quad 2 \leq j \leq m-1, \quad (32)$$

где C_1, C_2 — константы, подлежащие определению, а λ_1, λ_2 — корни характеристического уравнения

$$\lambda - 2\eta\lambda + 1 = 0, \quad \eta = (2\mu h)^{-1}, \quad (33)$$

$$\lambda_{1,2} = \eta \pm i\sqrt{1 - \eta^2}. \quad (34)$$

Условие возникновения энергетической зоны резонансной прозрачности (т.е. отсутствие затухания φ_j (32) вдоль квантовой резонансно-перколяционной траектории) есть $|\lambda_{1,2}| = 1$, что, как видно из (34), эквивалентно требованию $\eta^2 \leq 1$ или с учетом формулы (33) для η — требованию достаточно большой амплитуды подбарьерного рассеяния

$$|\mu| \geq (2h)^{-1}, \quad (35)$$

что имеет место при ε близких к ε_0 .

Учитывая, что амплитуда подбарьерного рассеяния при ε близких к ε_0 имеет вид [2]

$$\mu = \mu(\varepsilon) = -\frac{8\pi\alpha_0}{\varepsilon - \varepsilon_0}, \quad \alpha_0 = \sqrt{U_0 - \varepsilon_0}, \quad (36)$$

получаем из (35) с учетом формулы для h (30), что резонансное прохождение возможно при

$$|\varepsilon - \varepsilon_0| \leq \gamma, \quad (37)$$

где $\gamma = \gamma(u) = 4\alpha_0^2 u^{-1} e^{-u}$, $u = 2\alpha_0 y$.

Из (26)–(28) при учете (32) получаем систему уравнений для C_1 и C_2

$$\begin{cases} a_{11}C_1 + a_{12}C_2 = f_q a_q, \\ a_{21}C_1 + a_{22}C_2 = 0, \end{cases} \quad (38)$$

где

$$\begin{aligned} a_{1j} &= \left[\left(\frac{1}{\mu h} + \frac{\alpha + ik}{\alpha - ik} \right) \left(\frac{1}{\mu h} - \lambda_j \right) + 1 \right] \lambda_j^2, \\ a_{2j} &= \left[\left(\frac{1}{\mu h} + \frac{\alpha + ik}{\alpha - ik} \right) \left(\frac{1}{\mu h} - \lambda_j^{-1} \right) + 1 \right] \lambda_j^{m-1}, \quad j = 1, 2. \end{aligned} \quad (39)$$

Найдя C_1 и C_2 из (38), находим из (28), (32)

$$\varphi_m = \varphi_m(\varepsilon, \mathbf{q}) = \frac{f_q}{\Delta_m(\varepsilon)} \exp[\ln(\lambda_1 - \lambda_2)] a_q, \quad (40)$$

где $\Delta_m(\varepsilon) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ — определитель системы (38), вычисленный при энергии ε .

Подставляя теперь (40) в (31), а (31) в (25), находим

$$D_m^{res}(\varepsilon, \mathbf{q}, \rho, u) = \frac{\alpha^2 k^2}{\pi^4 (\alpha^2 + k^2)^2} \frac{k_q}{k} \exp\left\{-\frac{\alpha|\rho - \rho_m|^2}{y}\right\} \exp\left\{-\frac{yq^2}{\alpha}\right\} \exp\left\{-\frac{(\varepsilon - \varepsilon_0)^2}{\gamma^2}\right\}, \quad (41)$$

$$y = \frac{u}{2\alpha}.$$

Отсюда видно, что $D_m^{res} \sim 1$ при совместном выполнении условий: $|\rho - \rho_m| < \sqrt{y/\alpha}$, $q < \sqrt{\alpha/y}$, $|\varepsilon - \varepsilon_0| < \gamma$. Формула (41) обобщает соответствующую формулу (5.16) работы [2] на случай $\mathbf{q} \neq 0$ и уточняет зависимость резонансной прозрачности от ε . При $\mathbf{q} = 0$ и $\varepsilon = \varepsilon_0$ эти формулы совпадают.

5. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

С учетом (41), (13), (15) и (12) ВАХ (14) принимает вид

$$\langle i(v) \rangle = S \sum_{m=1}^{\infty} \int p_m(\varepsilon_F, u) i_m(v, u) du, \quad (42)$$

где

$$p_m(\varepsilon_F, u) = \alpha_F^2 c^m e^{-cm\pi u^3} [u^2 \cdot 2(mu/\mathcal{L} - 1)]^{m-1},$$

$$i_m(v, u) = \frac{1}{8\pi^3 \sqrt{\pi}} \frac{k_F^2 \alpha_F^2}{(\alpha_F^2 + k_F^2)^2} \gamma_F \operatorname{erf}\left(\frac{v}{\gamma_F}\right), \quad \gamma_F = \gamma_F(u) = 4\alpha_F^2 u^{-1} e^{-u},$$

а

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

— интеграл вероятности. Зависимость $\langle i(v) \rangle$ является существенно нелинейной, чем радикально отличается от таковой в «пустом» барьере.

Формально считая параметр m непрерывным, вычислим правую часть (42) методом перевала. Точка перевала находится из системы уравнений

$$\begin{aligned} -3\pi c m u^2 + 2(m-1)u^{-1} + m(m-1)(mu - \mathcal{L})^{-1} - 1 - u^{-1} + \xi(u, v) &= 0, \\ \ln c - \pi c u^3 + 2 \ln u + \ln 2 + \ln(mu - \mathcal{L}) - \ln \mathcal{L} + (m-1)u(mu - \mathcal{L})^{-1} &= 0, \end{aligned} \quad (43)$$

где

$$\xi(u, v) = \frac{\partial}{\partial u} \left[\ln \operatorname{erf}\left(\frac{v}{\gamma_F(u)}\right) \right].$$

Асимптотическое решение системы при $v \sim \gamma_F$, $\mathcal{L} \gg 1$, $c\mathcal{L}^2 \ll 1$ имеет вид

$$m_0 = \mathcal{L}^{1/2} |\ln(c\mathcal{L})|^{-1/2}, \quad u_0 = \mathcal{L}/m_0, \quad \theta_0 = |\ln(c\mathcal{L})|^{-1/2}. \quad (44)$$

При этом величина $\theta_0 \ll 1$, что оправдывает сделанное ранее предположение о том, что главный вклад в резонансный туннельный ток при малых концентрациях примесей (см. ниже (47), (48)) дают слабоизвилистые квантовые резонансно-перколяционные траектории.

Найдем интервал концентраций c , в котором резонансный туннельный ток $\langle i(v) \rangle$ существенно превышает ток «пустого» барьера $i_0(v)$,

$$\langle i(v) \rangle \gg i_0(v), \quad (45)$$

где

$$i_0(v) = S \frac{4\alpha_F^2 k_F^2}{\pi(\alpha_F^2 + k_F^2)^2} \frac{\alpha_F^2}{\mathcal{L}} e^{-2\mathcal{L}v}. \quad (46)$$

Подставляя (42) и (46) в (45) и ограничиваясь для оценки в формуле (42) членом с $m = 1$, получаем

$$ce^{-c\pi\mathcal{L}^3} \gg \frac{32\pi^2\sqrt{\pi}e^{-2\mathcal{L}}}{\mathcal{L}} \frac{v}{\gamma_F(\mathcal{L}) \operatorname{erf}(v/\gamma_F(\mathcal{L}))}. \quad (47)$$

Например, при $v \sim \gamma_F(\mathcal{L})$ для типичных значений $\mathcal{L} \sim 10$ из (47) имеем оценку

$$10^{-6} \ll c \ll 10^{-2}. \quad (48)$$

В этом интервале концентраций при $\mathcal{L} \sim 10$ и $v \sim \gamma_F(\mathcal{L})$ находим для точки перевала (44) (учитывая, что m — дискретный параметр)

$$m_0 = 1, \quad u_0 = \mathcal{L}. \quad (49)$$

Тогда ВАХ (42) принимает вид

$$\langle i(v) \rangle = S\alpha_F^2 ce^{-c\pi\mathcal{L}^3} i_1(v, \mathcal{L}), \quad (50)$$

где

$$i_1(v, \mathcal{L}) = \frac{1}{8\pi^3\sqrt{\pi}} \frac{k_F^2\alpha_F^2}{(\alpha_F^2 + k_F^2)^2} \gamma_F(\mathcal{L}) \operatorname{erf}\left(\frac{v}{\gamma_F(\mathcal{L})}\right).$$

В этих условиях, например, при $c \sim 10^{-3}$ резонансный туннельный ток $\langle i(v) \rangle$ превышает $i_0(v)$ на два порядка.

Дифференциальный туннельный контактанс

$$G_d(v) = \frac{d\langle i \rangle}{dv} = \frac{S}{4\pi^4} \frac{k_F^2\alpha_F^4}{(\alpha_F^2 + k_F^2)^2} ce^{-c\pi\mathcal{L}^3} \exp\left[-\frac{v^2}{\gamma_F^2(\mathcal{L})}\right], \quad (51)$$

рассматриваемый как функция напряжения v , представляет собой гауссову кривую с характерной шириной $\gamma_F(\mathcal{L})$. Если, как и выше, принять $\mathcal{L} \sim 10$, а $\alpha_F^2 \sim k_F^2 = \varepsilon_F \sim$

~ 10 эВ, то характерная энергетическая ширина первого ($m = 1$) резонанса $\gamma_F(\mathcal{L}) \sim \sim 10^{-3}$ эВ. Это значит, что для его экспериментального наблюдения необходима температура $T \ll 10$ К, а сам этот резонанс должен проявляться на масштабах напряжений $v \sim 10^{-3}$ В. Аналогичные оценки могут быть проделаны и для резонансов с $m > 1$.

Переходя к вычислению мезоскопических флуктуаций туннельного кондактанса, подставим (17) в (18), и, учитывая, что в рассматриваемом интервале концентраций (48) $p_m^{-1}(\varepsilon_F, u) \gg \pi \alpha_F^{-2} u^2$, формулу (18) приводим к виду

$$\langle \delta^2 \rangle^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{S}} \left[\frac{\sum_m \int p_m(\varepsilon_F, u) i_m^2(v, u) du}{\left[\sum_m \int p_m(\varepsilon_F, u) i_m(v, u) du \right]^2} \right]^{1/2}. \quad (52)$$

Оставляя для оценки в суммах (52) только главные члены с $m = 1$, получаем

$$\langle \delta^2 \rangle^{1/2} = \frac{1}{\alpha_F \sqrt{cS}} \exp\left(\frac{c\pi \mathcal{L}^3}{2}\right). \quad (53)$$

Из условия $\langle \delta^2 \rangle^{1/2} \ll 1$ следует ограничение снизу на площадь туннельного перехода

$$\sqrt{S} \gg \frac{1}{\alpha_F \sqrt{c}} \exp\left(\frac{c\pi \mathcal{L}^3}{2}\right), \quad (54)$$

обеспечивающее реальное самоусреднение туннельного кондактанса при рассматриваемых концентрациях примесей.

Литература

1. В. Я. Кирпиченков, ЖЭТФ 113, 1522 (1998).
2. И. М. Лифшиц, В. Я. Кирпиченков, ЖЭТФ 77, 989 (1979).
3. И. М. Лифшиц, С. А. Гредескул, Л. А. Пастур, *Введение в теорию неупорядоченных систем*, Наука, Москва (1982).